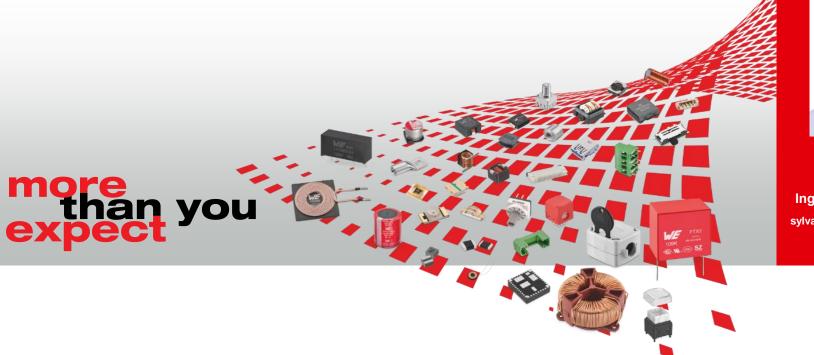




Quels composants passifs pour le GaN et le SiC





Sylvain LE BRAS
Ingénieur d'application
sylvain.lebras@we-online.com



Stéphane WAGNER
Responsable Grands
comptes Automobiles

stephane.wagner@we-online.com

Quels composants passifs pour le GaN et le SiC?

Quels composants passifs pour le GaN et le SiC

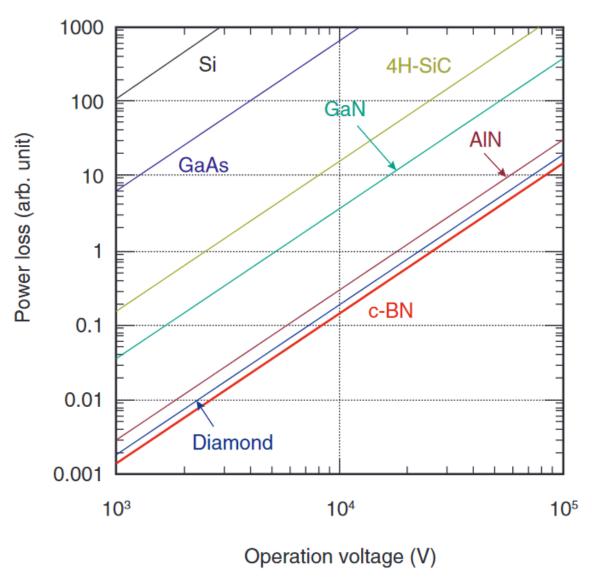


- Tendance historique ou rupture technologique ?
 - Evolution des :
 - Technologie des interrupteurs à semi-conducteurs
 - Fréquences de découpage
 - Densité de puissance
 - Boitiers des semi-conducteurs
 - Quels impacts sur les composants passif
- Perspectives et Impacts
 - Composants passifs : Réemploi ou Révolution



Evolution des technologies d'interrupteurs à semi-conducteurs





« Si » Silicium: Transistor Bipolaires / Si-MOSFET / IGBT

« GaAs » Arséniure de Gallium : pHEMT

« 4H-SiC » Carbure de Silicium SiC MOSFET

« GaN » Nitrure de Gallium : Gan-FET

« Nitrure D'aluminium »

« Nitrure De Bore Cubique »

 W_{Pk}

Pertes en conduction et pertes en commutation dans les semi-conducteurs

Phase de



ON

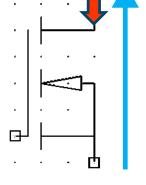
U = ID * Rds

Voltage

commutation OFF

Exemple d'application

- V = 20 V
- i = 4 A
- $\Delta t = 100 \text{ ns}$
- $Fsw = 500 \, kHz$



Current

Phase de conduction

 $P = R_{dson} * I_d^2$

ID = leakage

$$A = \frac{4}{3} \times \Delta t \times W_{Pk}$$

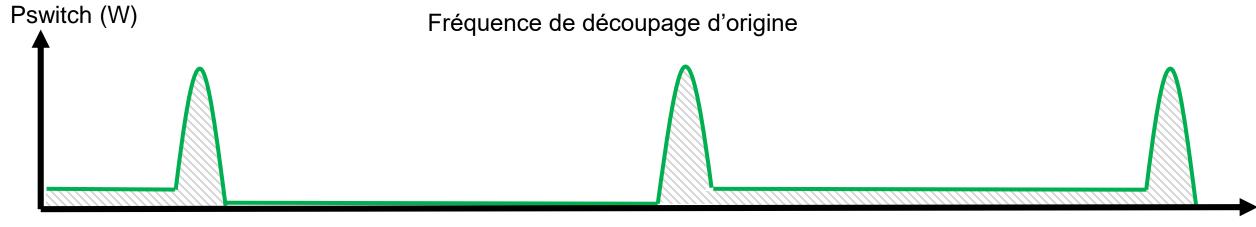
$$P_{\text{switching}} = 2 \times F_{\text{sw}} \times \frac{4}{3} \times \Delta t \times W_{\text{Pk}}$$

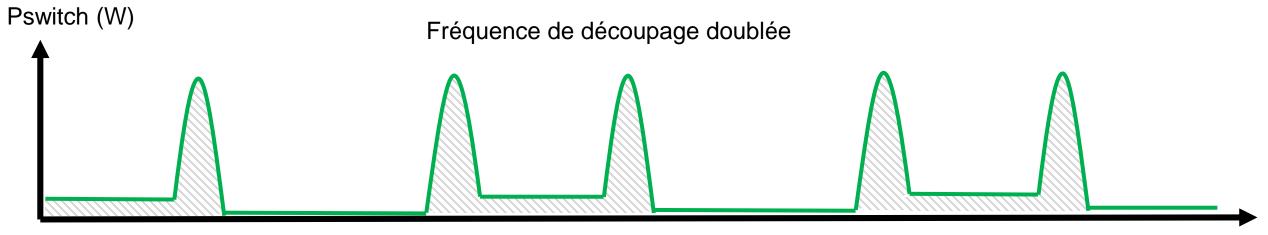
$$P = V_{DS} * I_{leak}$$

$$P_{\text{switching}} = 2,67 W$$

Pertes en conduction et pertes en commutation dans les semi-conducteurs







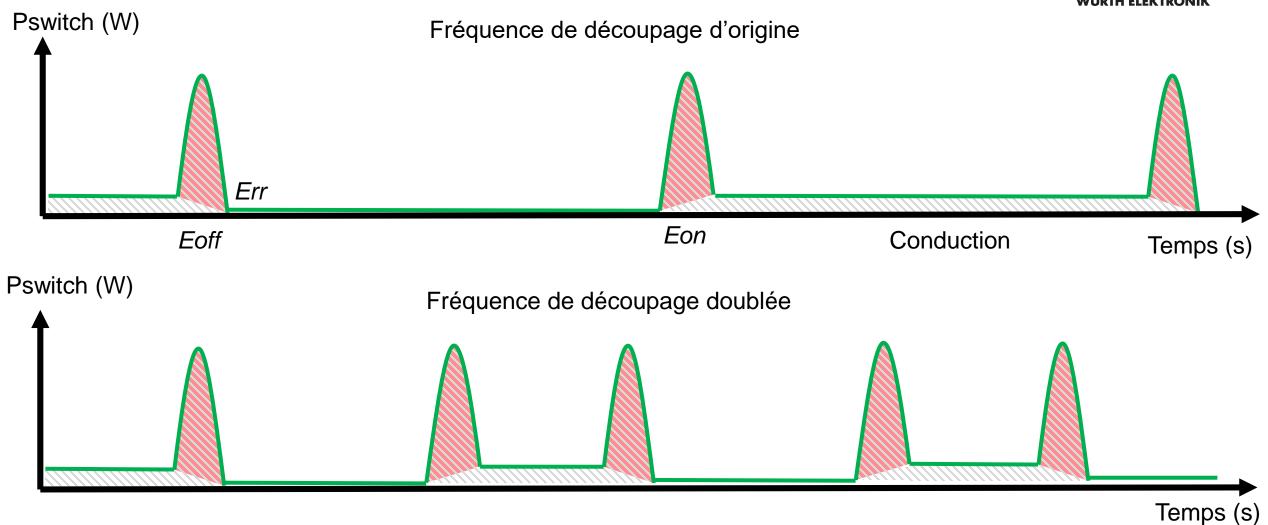
Pswitch (W)

11

Evolution des fréquences de découpage

Pertes en conduction et pertes en commutation dans les semi-conducteurs





 W_{Pk}

Pertes en conduction et pertes en commutation dans les semi-conducteurs

Phase de



ON

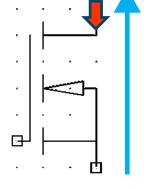
U = ID * Rds

Voltage

commutation OFF

Exemple d'application

- V = 20 V
- i = 4 A
- $\Delta t = 100 \text{ ns}$
- $Fsw = 500 \, kHz$



Current

Phase de conduction

 $P = R_{dson} * I_{d}^{2}$

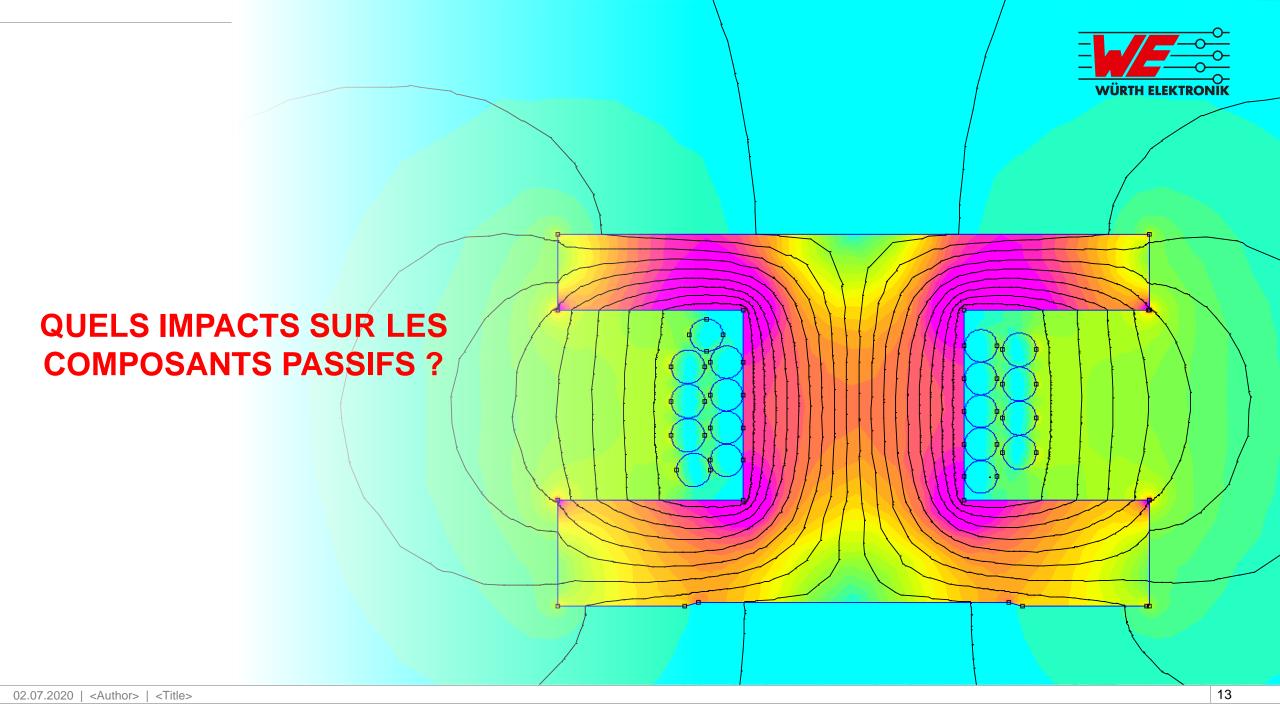
ID = leakage

$$A = \frac{4}{3} \times \Delta t \times W_{Pk}$$

$$P_{\text{switching}} = 2 \times F_{\text{sw}} \times \frac{4}{3} \times \Delta t \times W_{\text{Pk}}$$

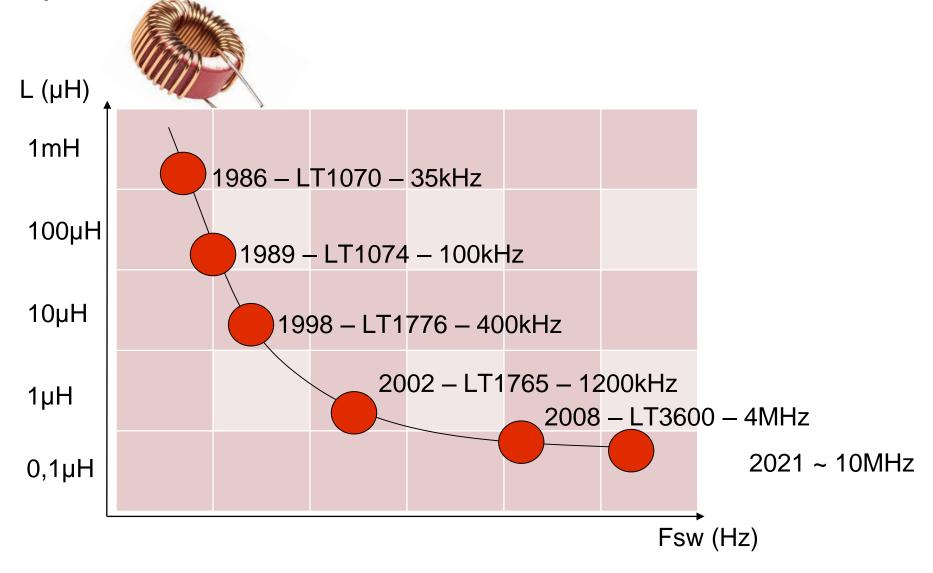
$$P = V_{DS} * I_{leak}$$

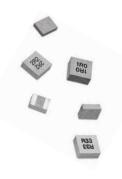
$$P_{\text{switching}} = 2,67 W$$



Impact sur la taille des inductances

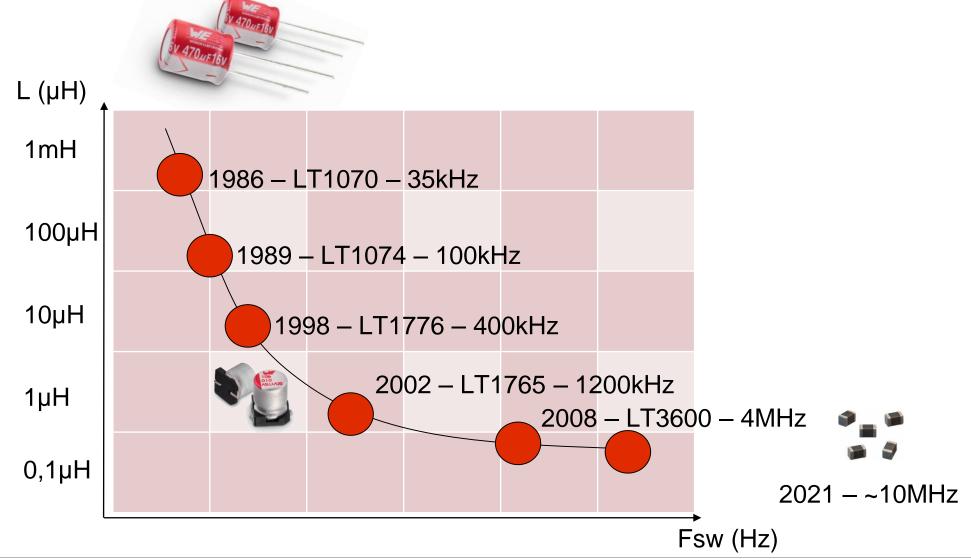






Impact sur la taille des condensateurs





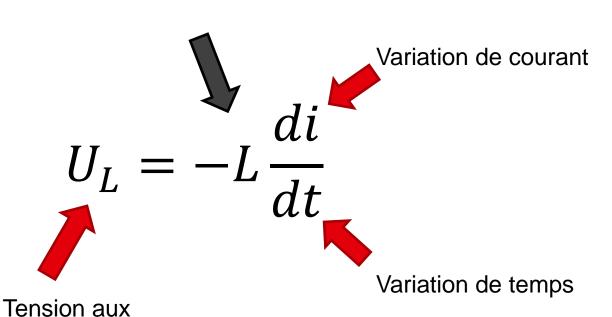
Impact concret sur les composants passifs





bornes de

l'inductance



Multiplication par 10 la fréquence de découpage



Division par 10 de la valeur inductive

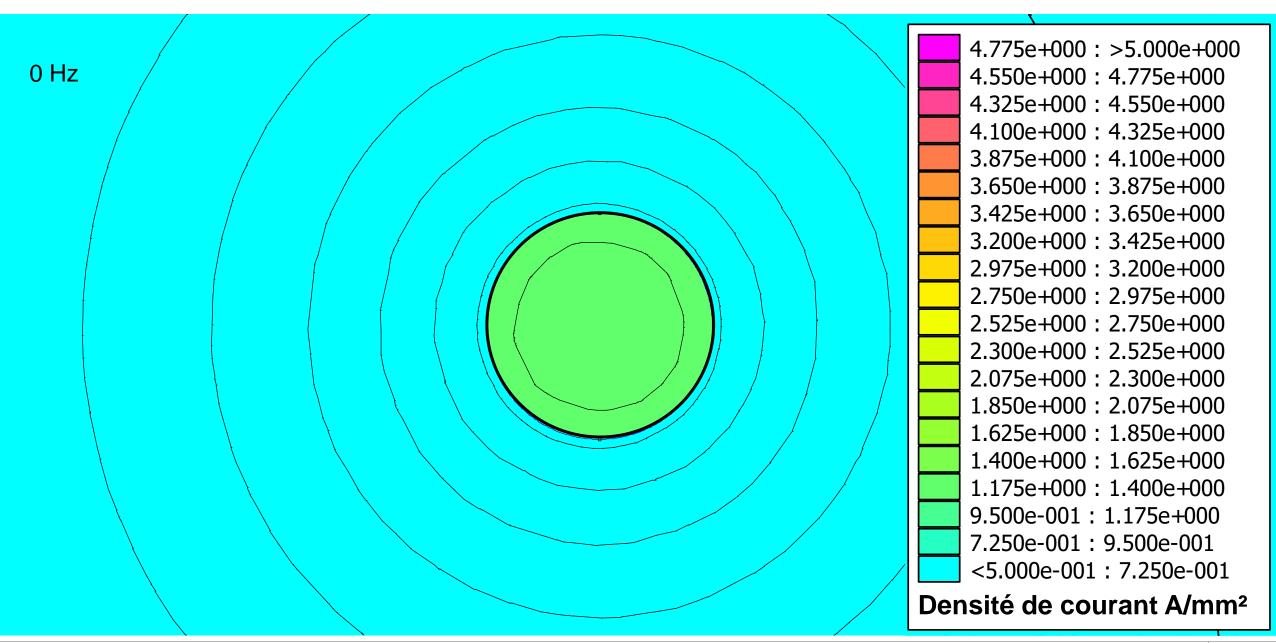


À Taille équivalente division par 5 à 10 du RDC

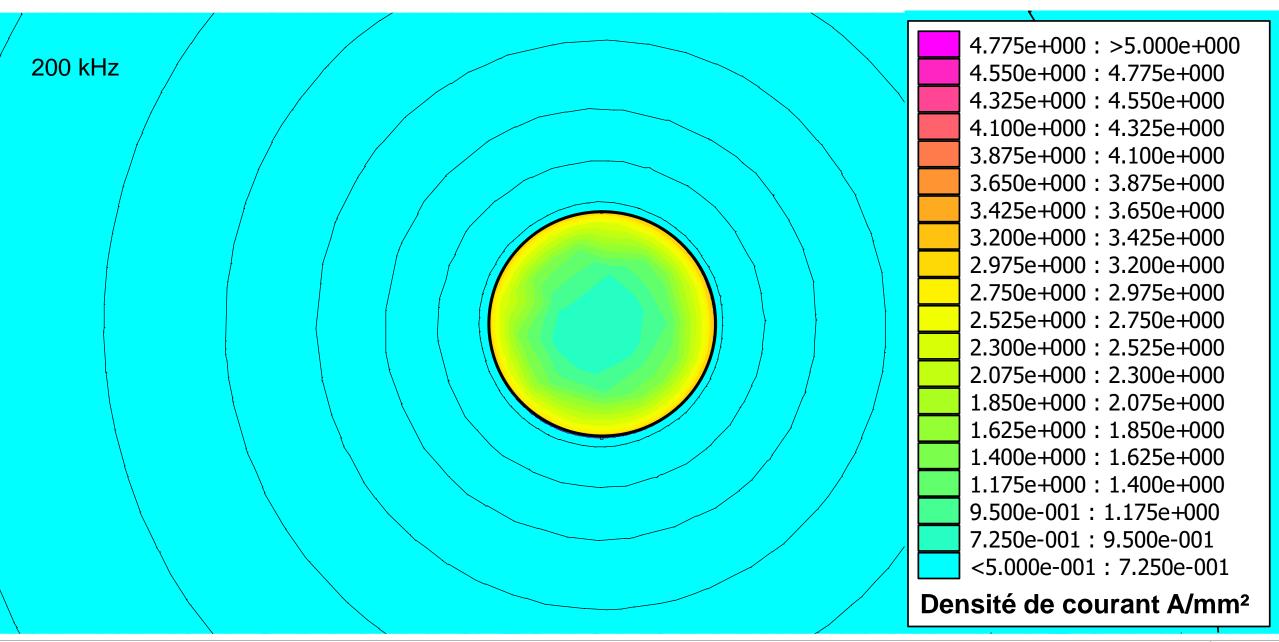




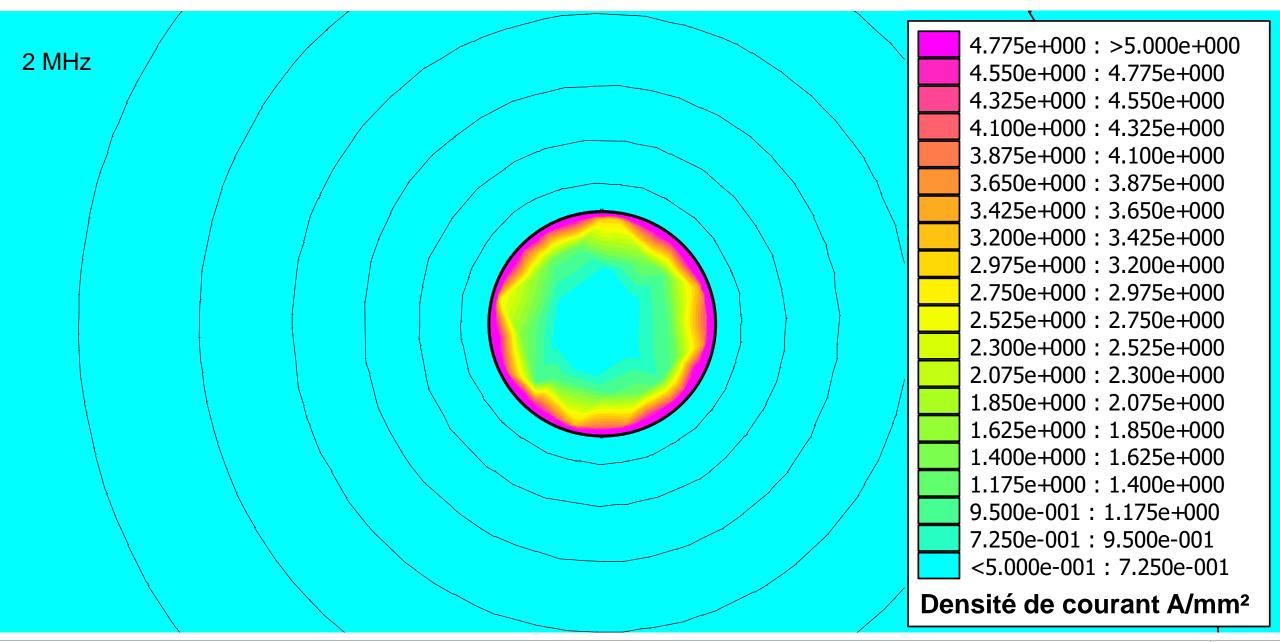
Effet de peau sur fil de cuivre 1mm



Effet de peau sur fil de cuivre 1mm



Effet de peau sur fil de cuivre 1mm

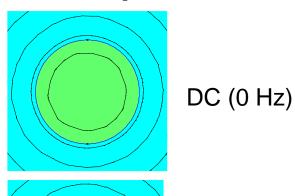


Impact concret sur les composants passifs

2 MHz

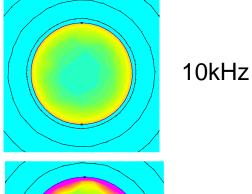


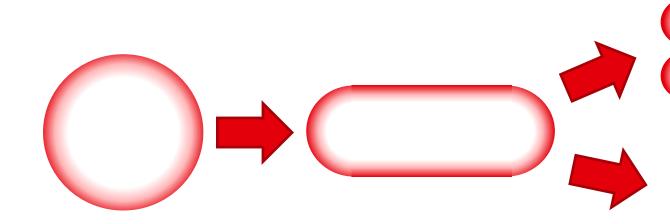
Effet de peau



$$\delta = \frac{7.5}{\sqrt{f}} \text{ cm}$$

Une ondulation de courant à haute fréquence fait circuler le courant (HF) dans la périphérie du conducteur





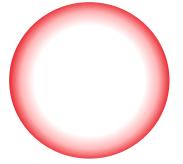
L'optimisation va consister à augmenter le rapport

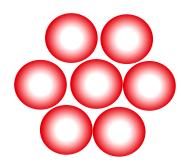
Périmètre / Section

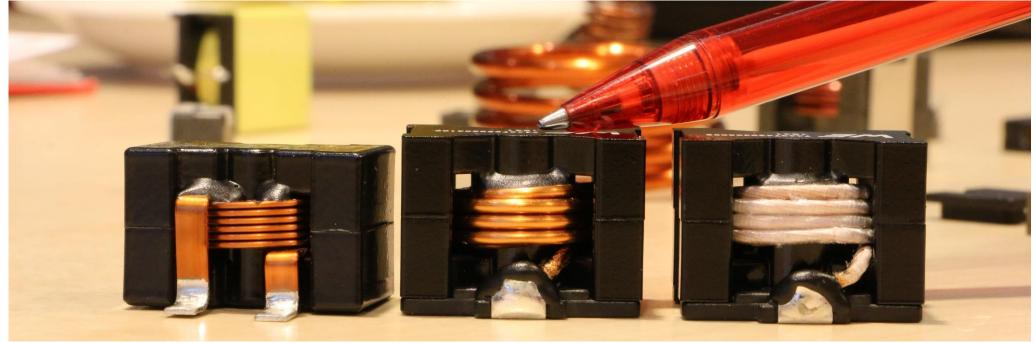
Impact concret sur les composants passifs



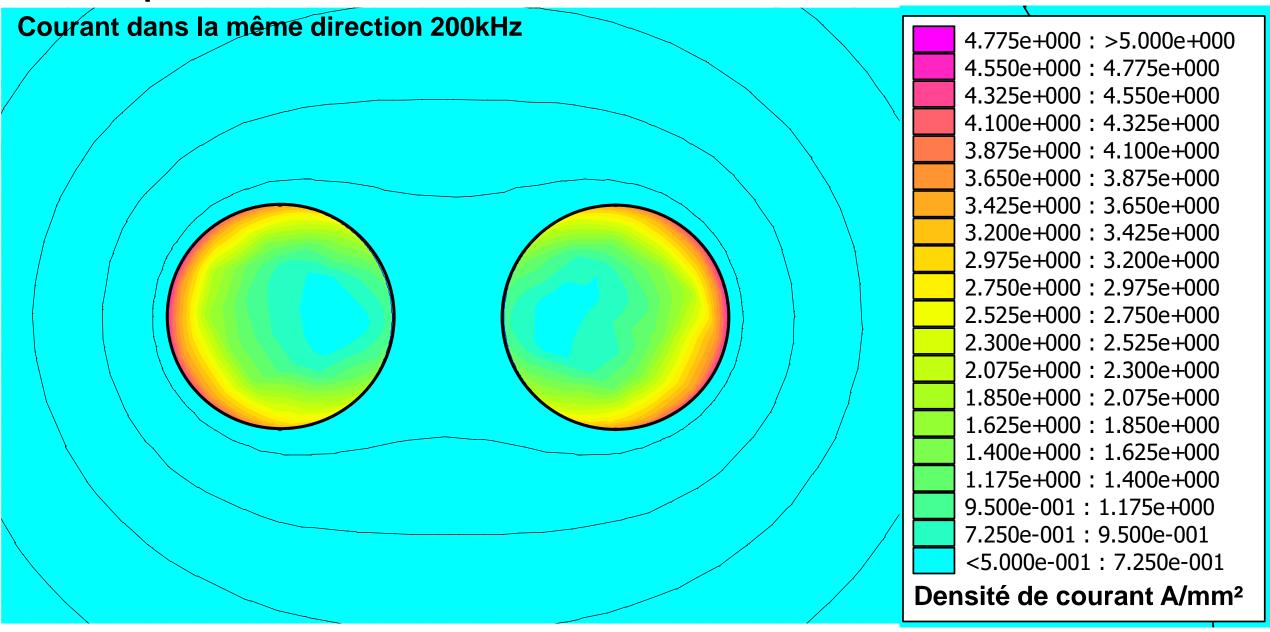




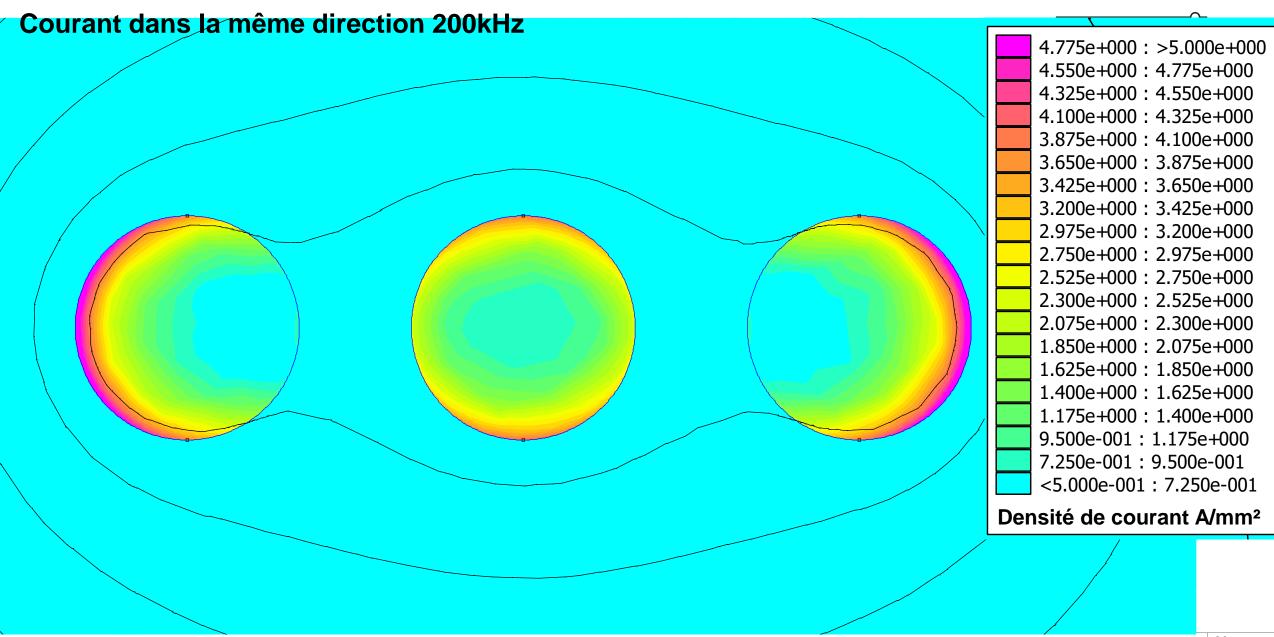


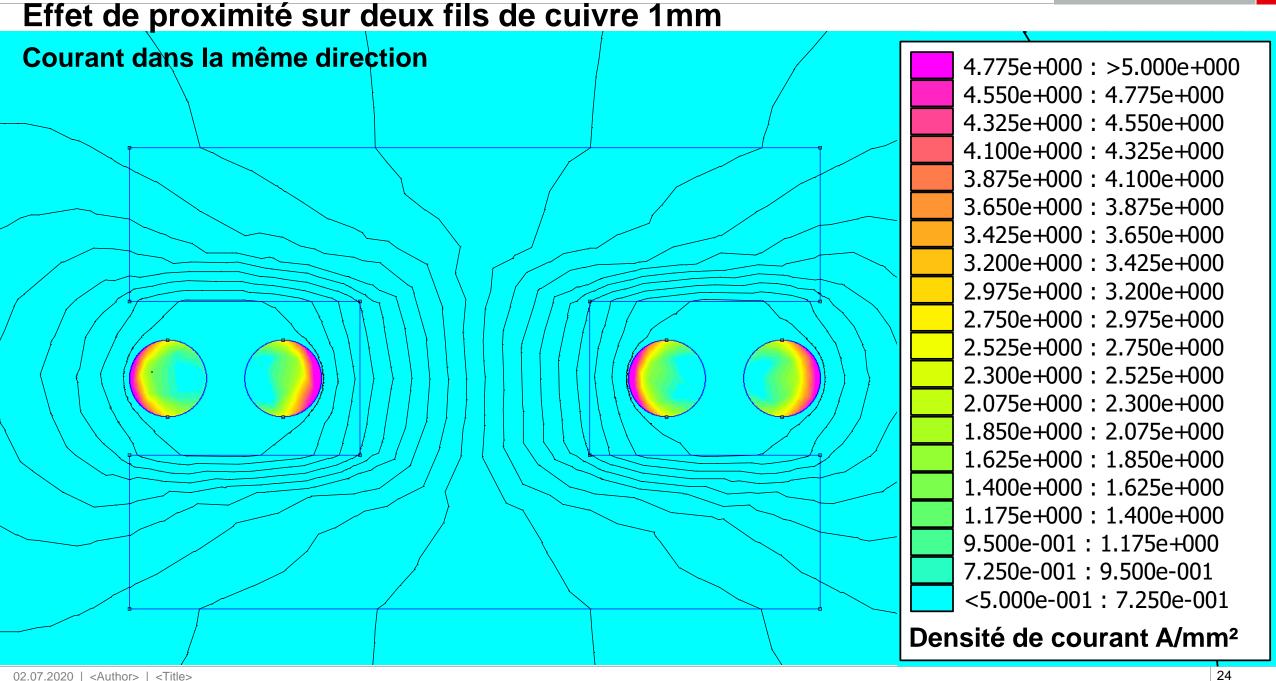


Effet de proximité sur deux fils de cuivre 1mm



Effet de proximité sur trois fils de cuivre 1mm





Impact concret sur les composants passifs

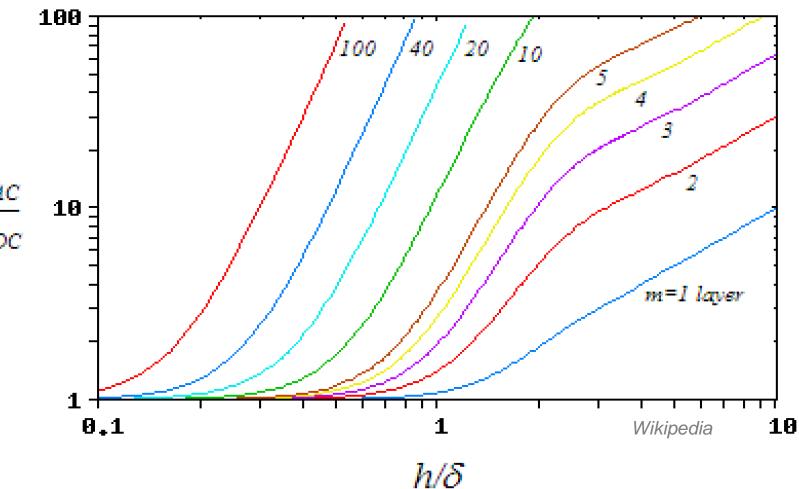


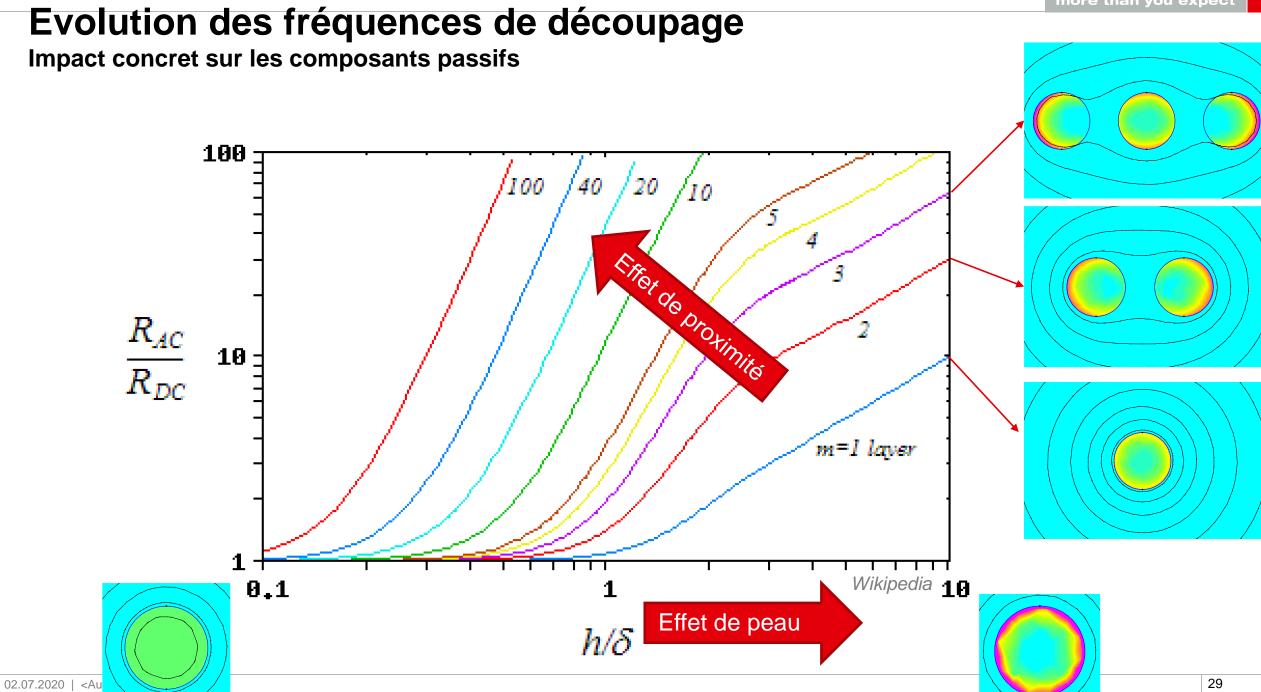
Effet de proximité

A haute fréquence les pertes par courant de Foucault dans les périphériques deviennent significatives, notamment si le nombre de couches est important

 $\frac{R_{AC}}{R_{DC}}$

L'optimisation va consister à réduire le nombre de couches superposées et leur disposition

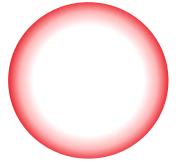


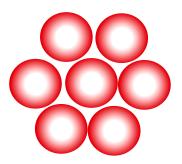


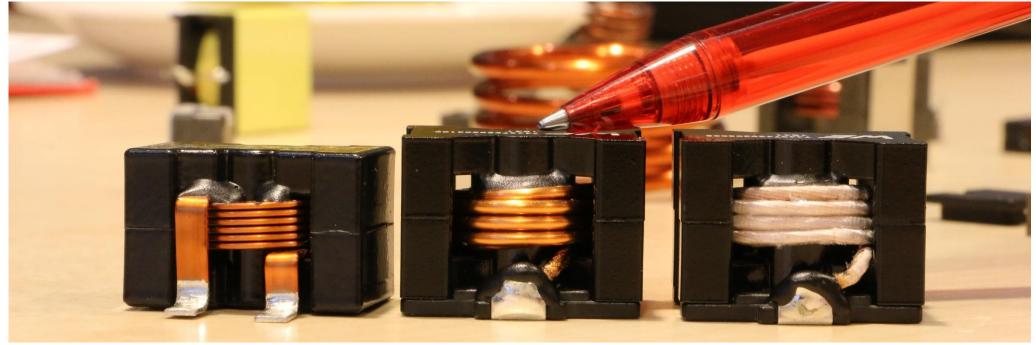
Impact concret sur les composants passifs







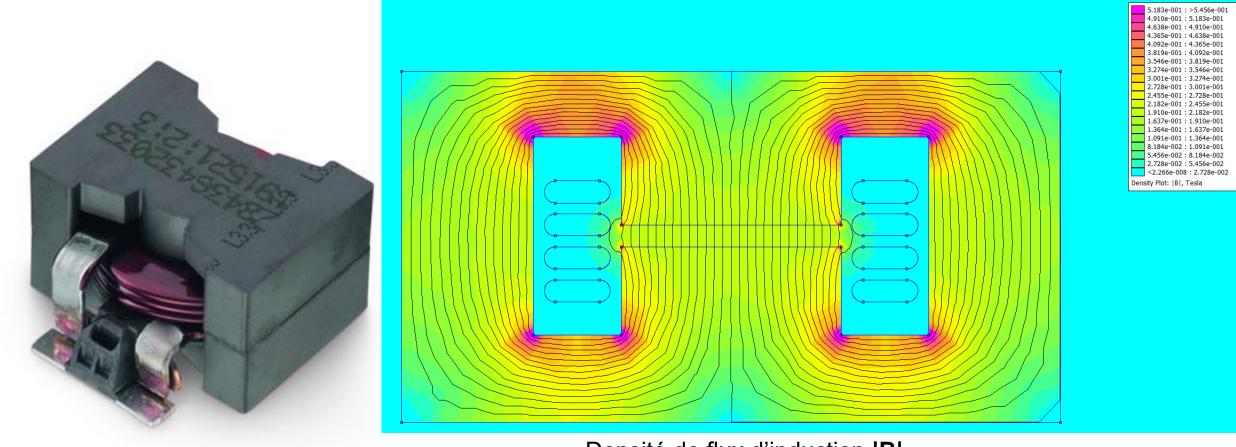




Impact concret sur les composants passifs



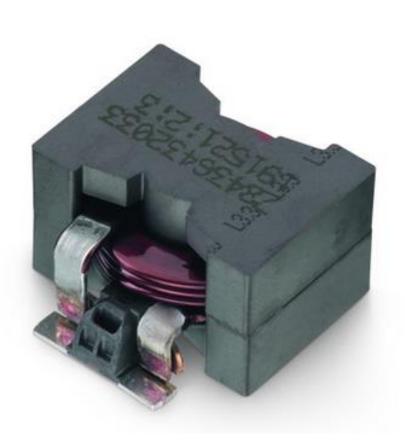
« Fringing Flux losses » en français « Effet de frange »



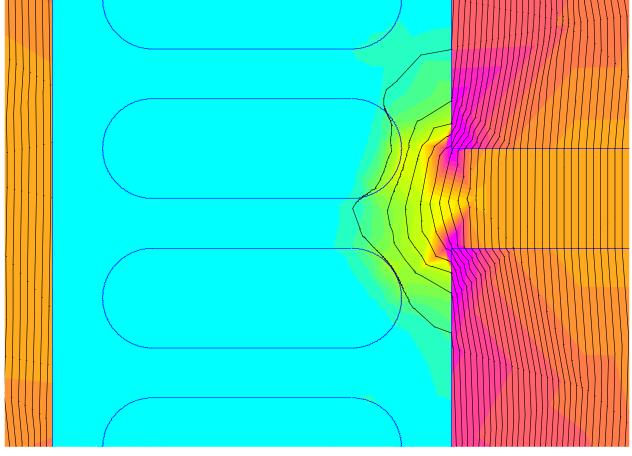
Densité de flux d'induction |B|

Impact concret sur les composants passifs





« Fringing Flux losses » en français « Effet de frange »



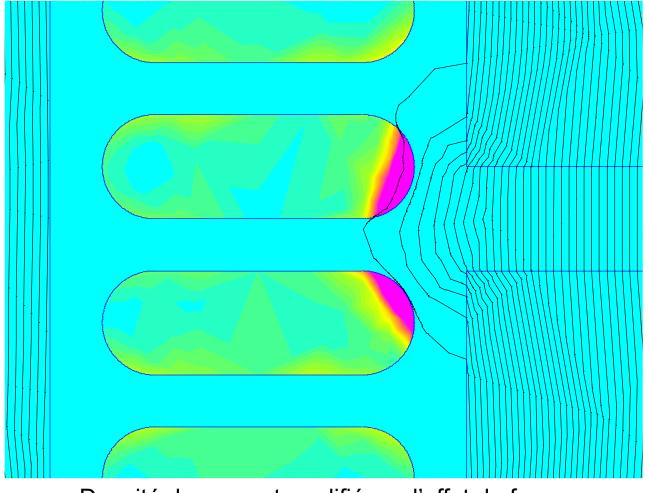
Densité de flux d'induction

Impact concret sur les composants passifs

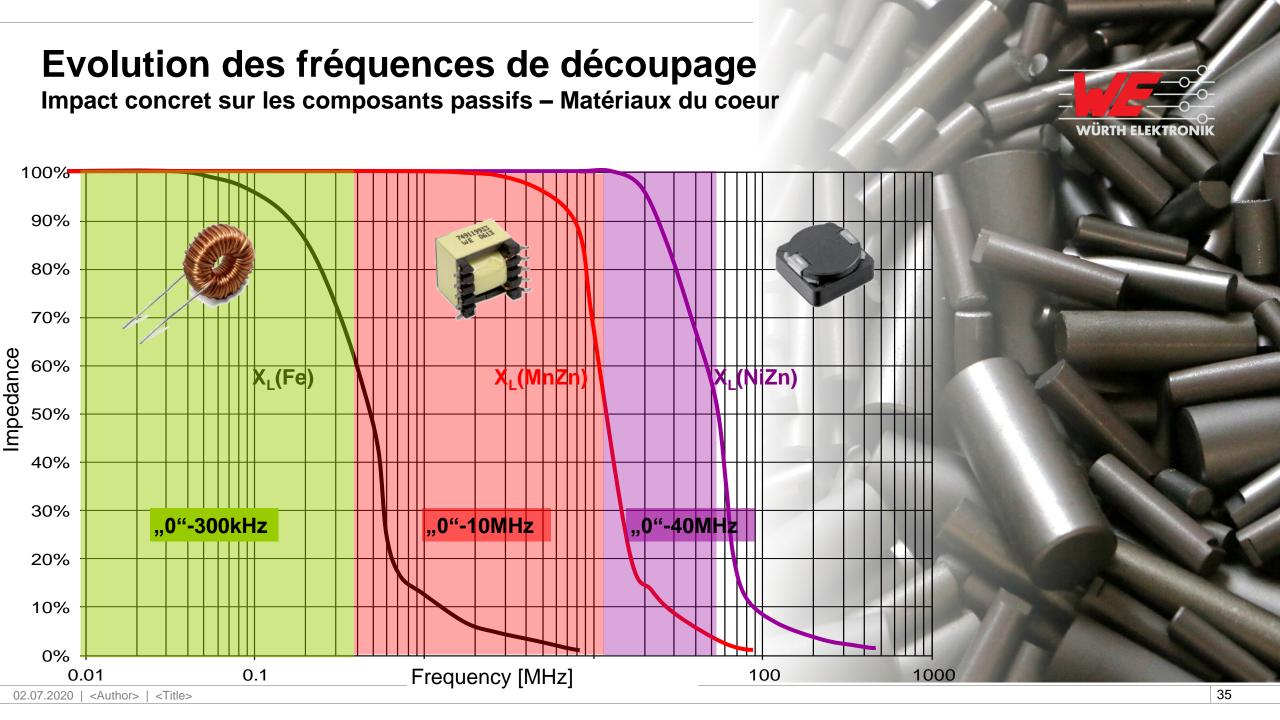


« Fringing Flux losses » en français « Effet de frange »



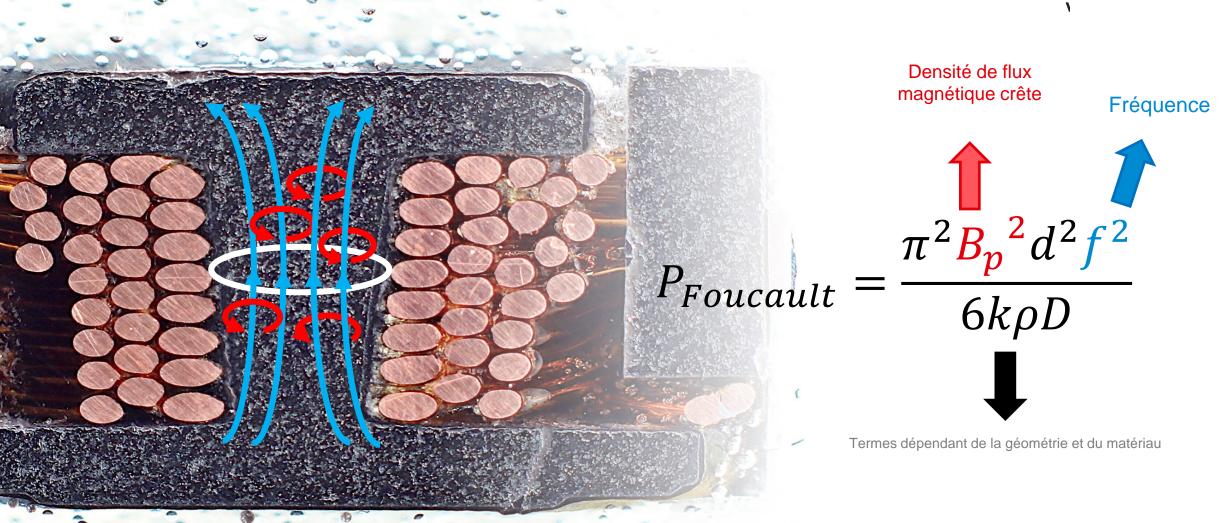


Densité de courant modifié par l'effet de frange



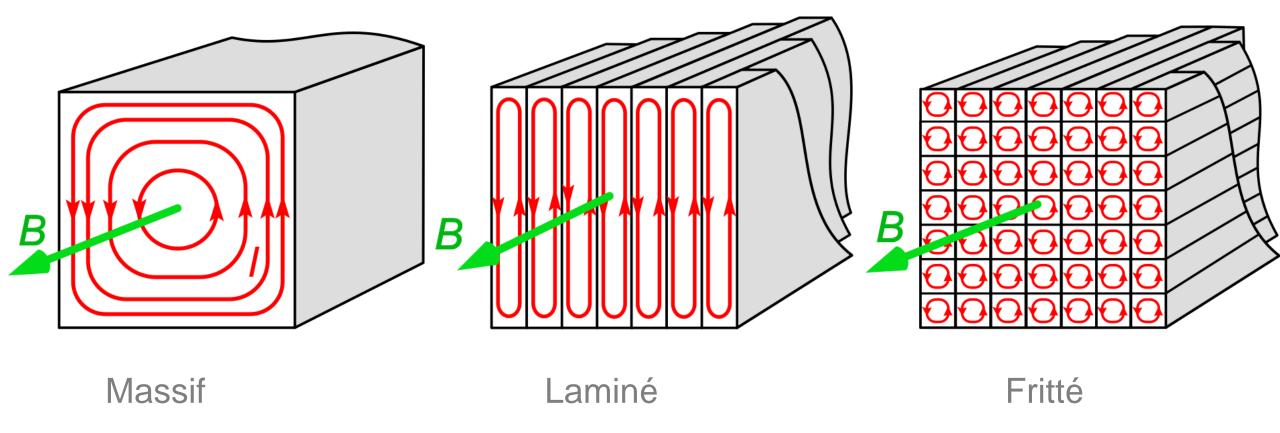
Impact concret sur les composants passifs - Matériaux du coeur





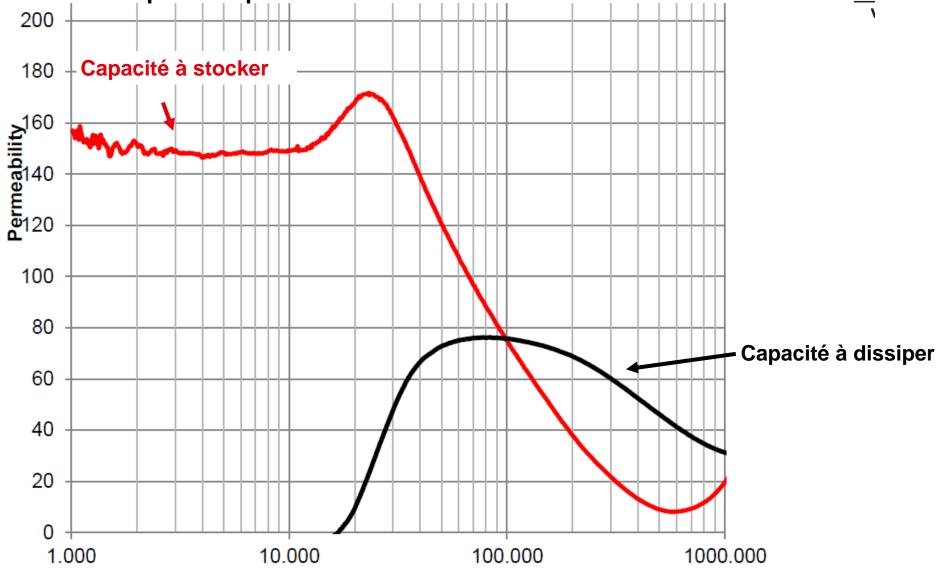
Impact concret sur les composants passifs - Matériaux du coeur





WÜRTH ELEKTRONIK

Impact concret sur les composants passifs – Matériaux du coeur

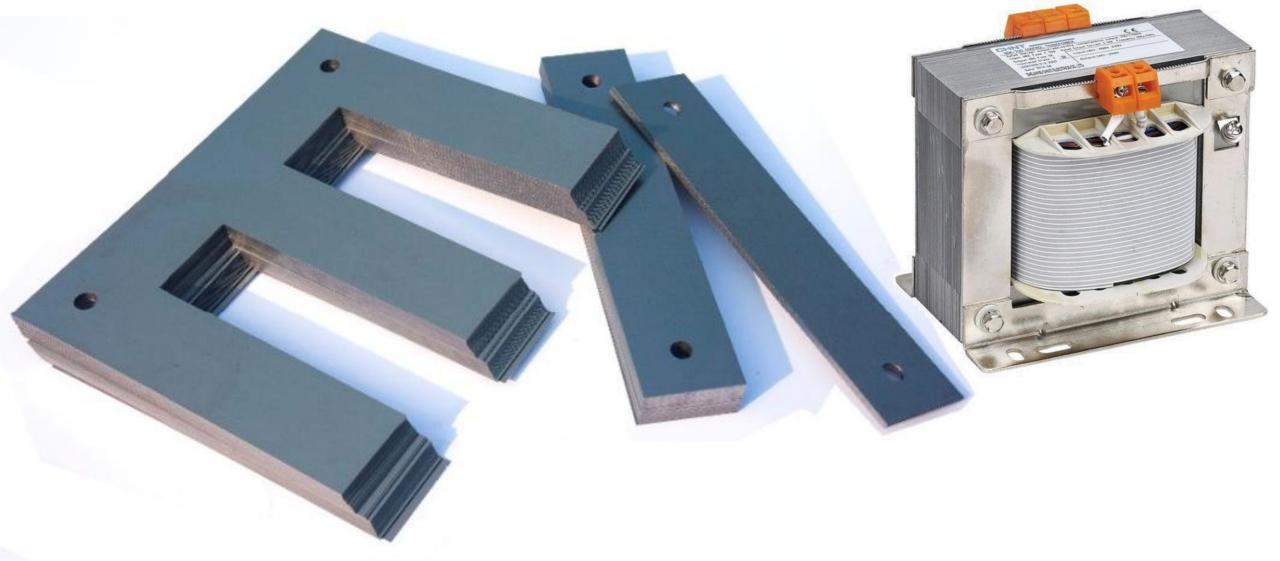


39

Evolution des fréquences de découpage

Impact concret sur les composants passifs - Matériaux du coeur





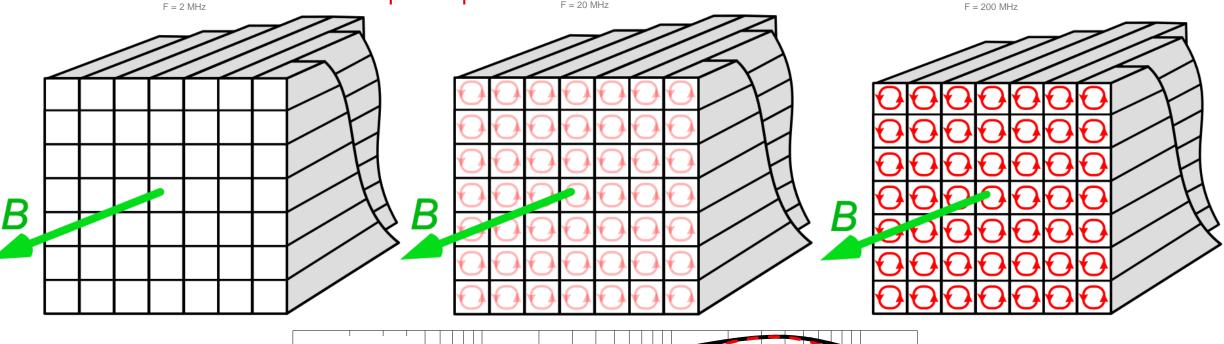
40

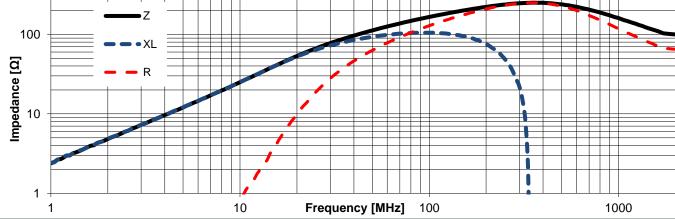
Evolution des fréquences de découpage

Impact concret sur les composants passifs - Matériaux du coeur



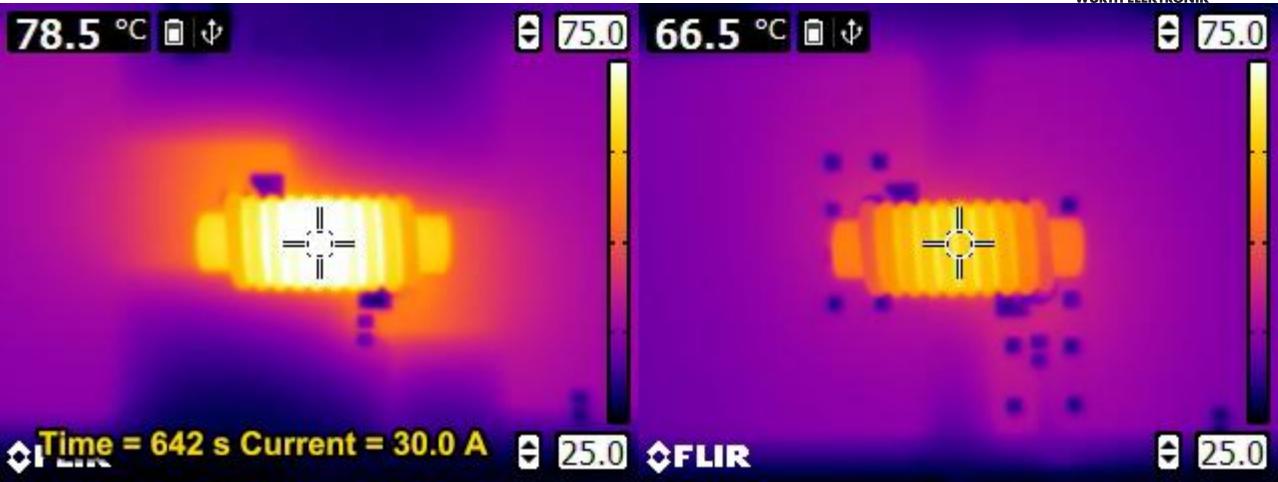
Les pertes par courant de foucault dans le coeur





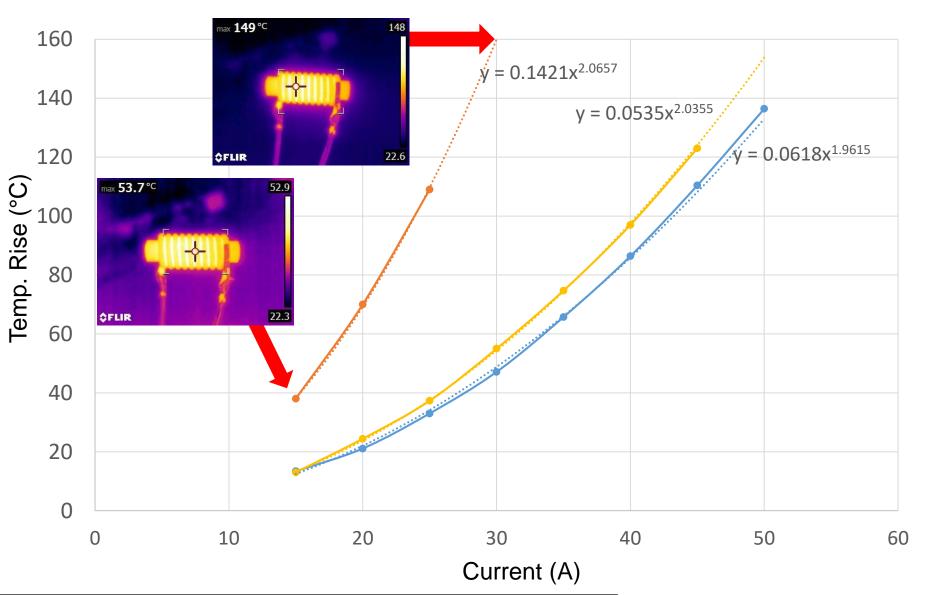
Profil de mission et impact sur le dimensionnement Inertie thermique du composant et drain thermique du PCB

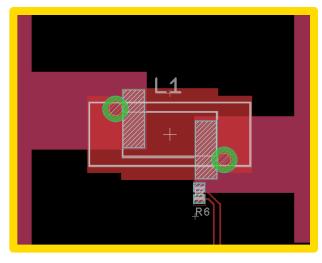
WÜRTH FI FKTRONII

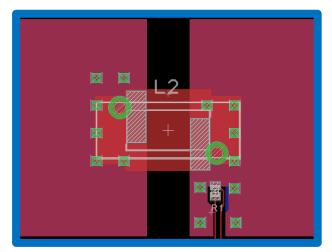


Impact du routage sur les échauffements









Exemple de montée en fréquence avec un composant spécifiquement adapté + contrôleur GaN



EPC9148 – 48 V Three-level Synchronous Buck Converter

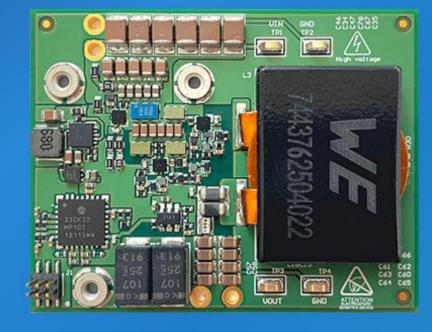
EPC9148: Ultra-Thin, multi-level converter for high performance computing systems.

The EPC9148 demonstration board is a 60 V maximum input voltage, 12.5 A maximum output current, 19 V output voltage, ultra-thin three-level synchronous buck converter with only 3.5 mm component height.

The EPC9148 features a GaN power stage, synchronous bootstrap gate drive circuit with the uP1966E gate drivers. The board also includes onboard housekeeping power supply, digital controller, current and voltage sensing, and output filter. Kelvin sensing test point of the input and output voltage are provided for accurate efficiency measurements.

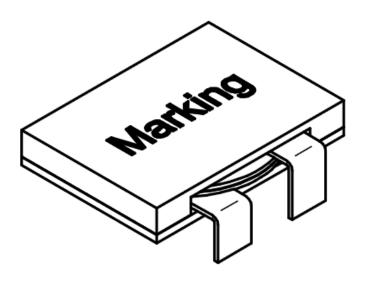
Features

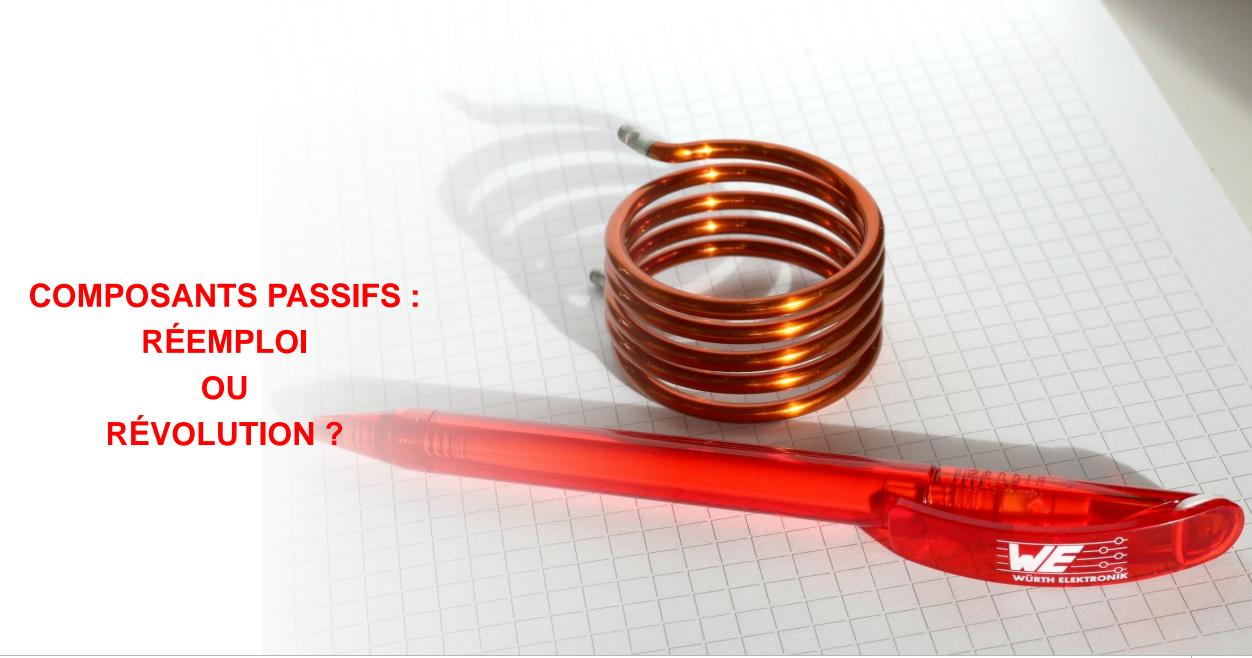
- 44 60 V_{IN} to 5 20 V_{OUT}
- FSW = 400 kHz, Max height < 4mm
- Peak efficiency = 98%, Up to 12.5 A



Applications

 High Performance Computing – ultra-thin laptops, high-end gaming systems





Une recette quasi inchangée depuis un siècle



Révolution dans la fabrication des composants passifs ?

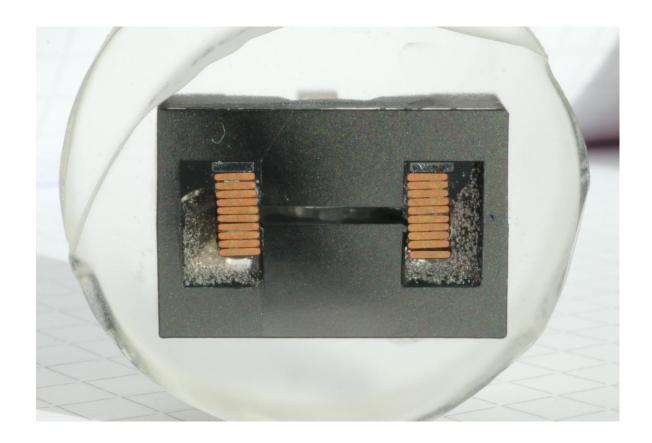


Fil de Litz Réduction des pertes cuivres Utile de 50kHz à 1MHz





depuis les années 1940

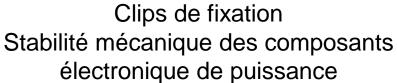


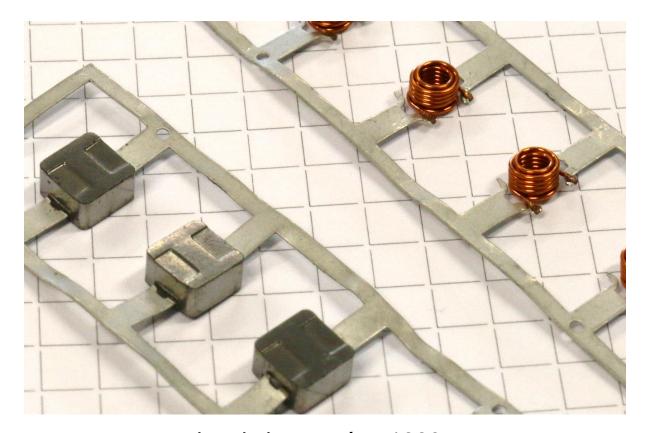
Révolution dans la fabrication des composants passifs ? La robustesse ?

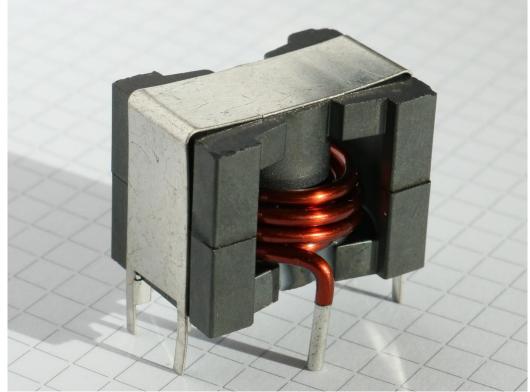


Inductances moulées

Densité de puissance et stabilité thermique accrues





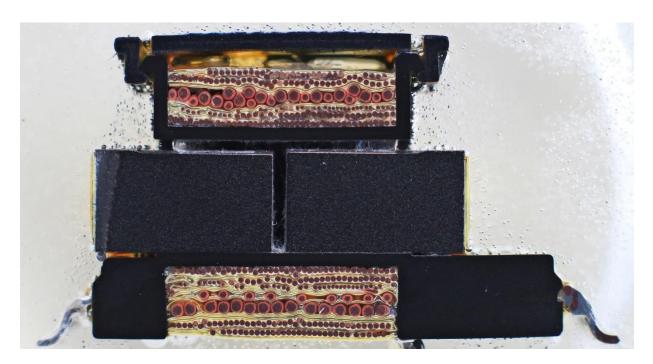


depuis les années 1990

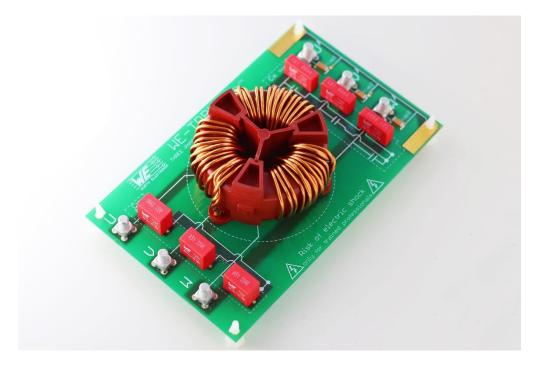
Révolution dans la fabrication des composants passifs ? Les tensions?



Fil Triple isolation – Films Isolants Tenue en tension >5kV



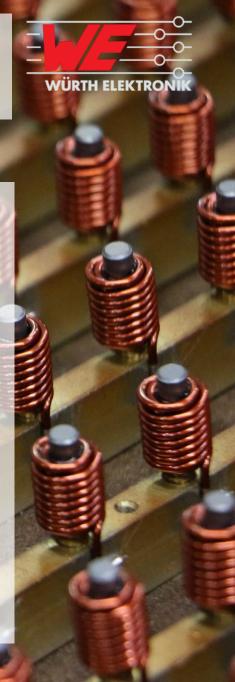
Boitiers de selfs de mode commun moulés Tension nominale de fonctionnement 760 Vrms



Quels composants passifs pour le GaN et le SiC? 0 ppm

Conclusion pour le GaN

- Le GaN se demarque à haute fréquence
- Les tensions des S.C. GaN augmentent et couvriront bientôt 100% des usages automobiles
- Le choix des passifs adaptés à la montée en fréquence permet de conserver les gains propres au GaN
- Comparer les composants sur la base de leur Rdc est impossible
 - Un composant avec un Rdc plus haut peut s'averer meilleur à haute fréquence
- Le fabricant de passifs peuvent vous conseiller et vous renseigner sur les gammes de produits adaptés
- Avec les hautes fréquences, les forts dv/dt et di/dt génèrent des problèmes CEM plus sévères
- Moins de valeur inductive = moins de tours
 - Il faut vérifier qu'il n'y a pas de risque de claquage « tour à tour »
 - Il faut vérifier le R_{AC},
- De nombreux phénomènes décrits ici sont également transposables au moteurs électriques / variateurs



Conclusion pour le SiC



- Le SiC se démarque :
 - A haute température
 - A haute tension
- Le choix des passifs adaptés à la montée en fréquence permet de conserver les gains propres au SiC
 - Matériaux stables en température (demander les températures de Curie et Saturation en T°)
- Moins de valeur inductive = moins de tours
 - Il faut vérifier qu'il n'y a pas de risque de claquage « tour à tour »
 - Il faut vérifier le R_{AC}
- Comparer les composants sur la base de leur Rdc est impossible
 - Un composant avec un Rdc plus haut peut s'avérer meilleur à haute fréquence
- Le fabricant de passifs peuvent vous conseiller et vous renseigner sur les gammes de produits adaptés
- Les forts dv/dt et di/dt génèrent des problèmes CEM plus sévères
- De nombreux phénomènes décrits ici sont également transposables au moteurs électriques / variateurs